

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019497

International filing date: 20 December 2004 (20.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-434888
Filing date: 26 December 2003 (26.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

20.12.2004

日本特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年12月26日
Date of Application:

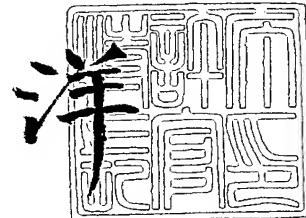
出願番号 特願2003-434888
Application Number:
[ST. 10/C] : [JP2003-434888]

出願人 古野電気株式会社
Applicant(s): 株式会社エクサ・テクノロジー

2005年 1月28日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



出証番号 出証特2005-3004013

【書類名】 特許願
【整理番号】 20030351
【提出日】 平成15年12月26日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H04B 1/26
G01S 7/285
H03D 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県西宮市芦原町9番52号
古野電気株式会社内

【氏名】 船江 明生

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県西宮市芦原町9番52号
古野電気株式会社内

【氏名】 大 浩司

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-7-5
プラムフィールド4F
株式会社エクサ・テクノロジー内
鳥塚 英樹

【特許出願人】

【識別番号】 000166247
【氏名又は名称】 古野電気株式会社

【特許出願人】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-7-5
プラムフィールド4F
株式会社エクサ・テクノロジー

【代理人】

【識別番号】 100084548
【弁理士】
【氏名又は名称】 小森 久夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013550
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9001588

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

ゲインを増幅状態から減衰状態の範囲で任意の値に切り替えることが可能なR F増幅器と、該R F増幅器にゲイン制御電圧を印加するスイッチ回路20とを含み、前記スイッチ回路20は、送信部が発振している時間およびその前後の時間を含む期間のみR F増幅器のゲインを減衰状態にし、それ以外の期間では増幅状態にするように、前記R F増幅器に印加するゲイン制御電圧を制御することを特徴とするマイクロ波周波数変換器。

【請求項2】

前記スイッチ回路20は、前記ゲイン制御電圧を連続的に変化させることで、R F増幅器のゲインを、増幅状態の所定のゲイン値から減衰状態の所定のゲイン値、または減衰状態の所定のゲイン値から増幅状態の所定のゲイン値に、連続的に切り替えることを特徴とする請求項1記載のマイクロ波周波数変換器。

【請求項3】

前記スイッチ回路20は、前記ゲイン制御電圧を瞬時に変化させることで、R F増幅器のゲインを、増幅状態の所定のゲイン値から減衰状態の所定のゲイン値、または減衰状態の所定のゲイン値から増幅状態の所定のゲイン値に、瞬時に切り替えることを特徴とする請求項1記載のマイクロ波周波数変換器。

【請求項4】

前記R F増幅器は、ゲートに負電圧、ドレインに正電圧を印加して動作するF E T素子またはH E M T素子を用い、前記スイッチ回路20は、前記素子のゲートおよびドレインに印加されるゲート電圧とドレイン電圧を同時にON/OFFし、ONにしたときにはR F増幅器のゲインを減衰状態にし、OFFにしたときにはR F増幅器のゲインを増幅状態にするように切り替えることを特徴とする請求項3記載のマイクロ波周波数変換器。

【書類名】明細書

【発明の名称】マイクロ波周波数変換器

【技術分野】

【0001】

本発明は、レーダ受信機に用いるマイクロ波周波数変換器に関する。

【背景技術】

【0002】

パルスレーダの一般的な構成を図6に示す。このパルスレーダは、マグネットロン1から発振周波数が例えば9.41GHzのパルス信号（例えばパルス幅1μs、出力10kW）を出力し、サーキュレータ2を介してアンテナ3から空中に放射し、物体にて反射した信号を再びアンテナ3で受け、リミッタ4を介して周波数変換器5に入力した信号は、局部発振器6の出力（局発信号）、例えば9.47GHzと混合し、例えば60MHzの中間周波数（IF信号）に変換する。変換したIF信号はIF増幅器7にて増幅し、信号処理回路8にてビデオ信号に変換して、レーダ表示装置（PPI）にて画像を表示する。なお、リミッタ4は大きな信号が入力することによって周波数変換器5が破損するのを防ぐために用いるもので、近年では、マイクロ波集積回路（MIC）を用いて周波数変換器5と一体になっているものが主流となっている。

【0003】

図6に示すようなパルスレーダに用いられるマイクロ波周波数変換器の従来の回路構成を図7に示す。この従来のマイクロ波周波数変換器は、MICリミッタ10の入力端子11に入力したパルス変調したマイクロ波信号（RF信号）をRF増幅器12で増幅し、ダブルバランスミキサ13に入れ、局部発振器14の信号（局発信号）と混合し、2つのIF出力をIF出力合成器15で合成し、IF出力端子16に合成出力を得るものである（特許文献1参照）。

【特許文献1】特開2001-111447号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところでアンテナから発射したレーダパルス信号は、反射物体が遠いほど小さな信号となって受信され、反射物体が近いほど大きな信号として受信され、また、反射物体が小さいほど小さな信号として受信され、反射物体が大きいほど大きな信号として受信される。

上述したような従来のマイクロ波周波数変換器には、次に示す様な欠点がある。図8の(A)は、RF増幅器付きの周波数変換器のRF入力電力に対するIF出力電力を示す。また、図8の(B)には、RF増幅器無しの周波数変換器のRF入力電力に対するIF出力電力を示す。すなわち、RF増幅器付き周波数変換器図8の(A)は、RF増幅器によって信号を増幅しているため、遠くまたは小さい反射物体の検出をするのに適しているが、図8の(A)に示すように、RF信号が例えば-5dBmの段階で飽和が始まり、近くまたは大きな反射物体で反射して来た-5dBm以上の信号に対しては、飽和してしまうため、検出できない。すなわち、近距離は受信できない。

【0005】

これに対し、RF増幅器無しの周波数変換器は、図8の(B)に示すように、+3dBmまでの入力に対して飽和せずに検出が可能である。

【0006】

ただし、RF増幅器無しの周波数変換器は、信号を増幅していないため、遠くまたは小さい反射物体の検出をするのには適していない。

【0007】

ところが近年のレーダでは、船同士または船と固定物との衝突防止が主目的となりつつあり、現状よりもさらに近くの反射物体の検出が可能な性能が望まれている。もちろん、従来から持っているレーダの性能として遠くまたは小さい反射物体を検出する性能も必要不可欠である。すなわち、遠距離から従来品よりもさらに近距離まで受信可能なレーダが

望まれるようになってきている。

【0008】

また、パルスレーダは、マグネットロン1から発振周波数が例えば9.41GHzのパルス信号（例えばパルス幅1μs、出力10kW）を出力しているため、サーキュレータ2を介しても直接リミッタ4側に漏れてくる過大な電力が周波数変換器5に入力する。

【0009】

この過大な電力によって周波数変換器5に用いられている局部発振器6の発振周波数が変化してしまい、例えば60MHzの中間周波数（IF信号）が変化する。中間周波数（IF信号）が変化すると中間周波增幅器の増幅度が変化してしまい、極端な場合には、受信感度が悪くなるので、局部発振器6の発振周波数は変化しないことが望まれている。

【0010】

上記、図8の（A）、（B）の両方を兼ね備えた特性を持った従来のマイクロ波周波数変換器として図9に示すものがある。

【0011】

すなわち、従来のRF増幅器12の前段にPINスイッチ17を設けたものである。

【0012】

PINスイッチ17は、トリガ入力によってRF入力をON-OFFする。

【0013】

自機のマグネットロンから直接入力する過大なRF信号がRF増幅器12に印加する前にトリガ入力によってPINスイッチ17をONし、また、近距離からの過大な反射信号がRF増幅器12に入らなくなるまで継続し、RF増幅器12に入力するRF信号がRF増幅器12の飽和入力以下になったらPINスイッチ17をOFFし通常のマイクロ波周波数変換器に戻すものである。

【0014】

しかし、PINスイッチ17はOFF状態でも挿入損失が1dB程度残存してしまうため、PINスイッチ17がない従来のマイクロ波周波数変換器に比べて、遠くまたは小さい反射物体の検出をするのに適さない。また、PINダイオード1段で構成したPINスイッチ17の減衰量は、約15dB程度であり、極近距離からの過大な反射信号に対しては減衰量が不足である。また、減衰量を増やすためにPINダイオードを2段にするとさらに残存する挿入損失が増加してしまう欠点がある。

【0015】

本発明は上記従来の問題点を解消すべくなしたもので、従来のRF増幅器付きのマイクロ波周波数変換器と同一の性能を持って遠距離または小さい物体からの反射を受信することができ、PINスイッチによるON-OFFよりもさらにごく近距離まで受信可能で、その上マグネットロン1からの直接の電力によって局部発振器6の発振周波数が変化しないマイクロ波周波数変換器を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

【0016】

本発明のマイクロ波周波数変換器のうち請求項1に係るものは、上記目的を達成するために、ゲインを増幅状態から減衰状態の範囲で任意の値に切り替えることが可能なRF増幅器と、該RF増幅器にゲイン制御電圧を印加するスイッチ回路20とを含み、前記スイッチ回路20は、送信部が発振している時間およびその前後の時間を含む期間のみRF増幅器のゲインを減衰状態にし、それ以外の期間では増幅状態にするように、前記RF増幅器に印加するゲイン制御電圧を制御することを特徴とする。

【0017】

また本発明のマイクロ波周波数変換器のうち請求項2に係るものは、上記目的を達成するため、スイッチ回路20は、前記ゲイン制御電圧を連続的に変化させることで、RF増幅器のゲインを、増幅状態の所定のゲイン値から減衰状態の所定のゲイン値、または減衰状態の所定のゲイン値から増幅状態の所定のゲイン値に、連続的に切り替えることを特徴とする。

[0018]

また本発明のマイクロ波周波数変換器のうち請求項3に係るものは、上記目的を達成するに、スイッチ回路20は、前記ゲイン制御電圧を瞬時に変化させることで、RF増幅器のゲインを、増幅状態の所定のゲイン値から減衰状態の所定のゲイン値、または減衰状態の所定のゲイン値から増幅状態の所定のゲイン値に、瞬時に切り替えることを特徴とする。

[0 0 1 9]

また本発明のマイクロ波周波数変換器のうち請求項4に係るものは、上記目的を達成するため、RF増幅器は、ゲートに負電圧、ドレインに正電圧を印加して動作するFET素子またはHEMT素子を用い、前記スイッチ回路20は、前記素子のゲートおよびドレインに印加されるゲート電圧とドレイン電圧を同時にON/OFFし、ONにしたときにはRF増幅器のゲインを減衰状態にし、OFFにしたときにはRF増幅器のゲインを増幅状態にするように切り替えることを特徴とする。

[0 0 2 0]

以上の構成により、従来のRF増幅器付きのマイクロ波周波数変換器と同一の性能を持って遠距離または小さい物体からの反射を受信することができ、さらにごく近距離まで受信可能で、その上マグнетロンからの直接の電力によって局部発振器の発振周波数が変化しないマイクロ波周波数変換器を提供することが可能になる。

【発明の効果】

【0021】

本発明のマイクロ波周波数変換器は、従来のマイクロ波周波数変換器に比べて近距離から反射してきた信号を飽和することなく受信でき、したがって遠距離から、近年の船舶レーダの主な使用目的である船舶同士または固定物などとの衝突防止に関して非常に重要な機能であるごく近距離までの目標物体の認識が可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

九月二十六日

以下本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

以 1 本充 4 本

【0023】 図1は、本発明に係るマイクロ波周波数変換器の回路構成図である。本実施形態のマイクロ波周波数変換器は、外部からマグнетロン出力に同期し、マグネットロンが出力する時間を持むトリガ電圧を必要とし、トリガ電圧がスイッチ回路20に入力すると、その入力に応じて、ゲイン制御電圧を制御する構成である。

100241

[0025]

図1に従って本実施形態の動作原理を説明する。本実施形態のマイクロ波周波数変換器は、MICリミッタを除いて記載してある。マグнетロンから直接のパルス変調されたマイクロ波信号（RF信号）が入力端子18に入力する直前にトリガ（パルス）電圧をトリガ入力端子19に印加する。トリガ電圧によってスイッチ回路20を動作させ電源回路から供給されるゲイン制御電圧、すなわちゲート電圧とドレイン電圧を同時に0Vにすることにより、RF増幅器21の電圧を遮断する。このことにより、RF増幅器21に使用しているFETはミキサ13の前段に一種の抵抗減衰器が接続されたと同じ特性を示す。すなわち、図8の（B）のRF増幅器無しの周波数変換器の前段に減衰器が接続されRF増

幅器無しの図8の(B)の入出力特性より10数dB減衰した入出力特性を示すことになる。

【0026】

一回のトリガに対してFETへのバイアスをゼロにしている時間は、レーダによって異なるが、RF信号が終わってから数 μ sから数10 μ sの間ゼロバイアスに保持され、その後通常電圧に復帰する。

【0027】

図2に本発明のマイクロ波周波数変換器のタイミングチャートを示す。なお、同図のドレインおよびゲート電圧が、前述のゲイン制御電圧に相当する。

【0028】

マグネットロンが発振する前にトリガ入力を印加し、ゲイン制御電圧、すなわちドレインおよびゲート電圧を0Vにしておくことにより、過大なRF信号はマイクロ波周波数変換器の内部では、10数dB減衰していて、局部発信器の周波数に影響しない程度に小さくすることが出来る。

【0029】

RF信号がレーダアンテナから放射され、電波の反射物体で反射する前にRF入力は終了するがRF信号が終了して直ぐに反射して戻ってくる信号は、極近距離からのものであり、従来のマイクロ波周波数変換器は飽和してしまうが、本発明のマイクロ波周波数変換器は、その間トリガによってONしており、トリガ入力がONの間はゲイン制御電圧、すなわちゲート電圧、ドレイン電圧の両方が0Vとなっているため過大な反射信号でも飽和しない。

【0030】

図3に、本発明のマイクロ波周波数変換器について、トリガ電圧をON-OFFした時(そのトリガ入力を受けたスイッチ回路20が、ゲイン制御電圧を瞬時に変化させた時)のRF入力電力に対するIF出力電力の実測結果を示す。

【0031】

図3に示す通り、トリガがOFFの時は、ドレインおよびゲート電圧が共にONであり、ゲインが約+6dBで1dB圧縮時入力電力は約-2dBmであるのに対し、トリガをONすると、ドレインおよびゲート電圧が共にOFFであり、ゲインは約-25dBで1dB圧縮時入力電力は+20dBmを超えている。トリガがOFFの時の出力の飽和現象は、マイクロ波周波数変換器に使用しているミキサによるものである。したがってトリガをONした時の飽和もミキサによって飽和するので、IF出力の飽和値はトリガのON-OFF、すなわちドレインおよびゲート電圧のON-OFFによって差は生じない。

【0032】

このため、トリガがONの時のIF出力値は、トリガがOFFの時のIF出力値と一致するまで飽和することではなく、過大な反射信号を受信することができる。

【0033】

FETを用いたRF増幅器の9.41GHzにおける一般的な増幅度は約12dBであるに対しRF増幅器の電源を0Vにした時の減衰量は約20dBであるので、その差が図3に表現されている。

【0034】

図1に示したスイッチ回路20の一実施例を図4に示す。

【0035】

RF増幅器に使用するFET25のバイアス制御回路にオペアンプ26を用いる。

【0036】

オペアンプ26のバイアスとして+5Vと-5Vを用い各々の端子にR1、R2、R3、R4の抵抗を接続し、トリガ入力電圧が+5Vの時FET25のドレインに約10mAの電流が流れる様にR2の抵抗を接続する。

【0037】

その時FET25のゲート電圧は約0.4Vである。この値は使用するFET25の性

能によって異なるので、R F増幅器のN F（雑音指数）が最小になるようにドレイン電流を選ぶことが望ましい。

【0038】

このバイアス条件においてトリガ入力を0 Vにすると、ゲイン制御電圧、すなわちF E T 2 5のドレインとゲートの電圧が同時に0 Vになり本発明の効果を発揮する。

【0039】

つまり、図4のトリガ電圧が+5 Vの時、図3のトリガOFFの特性を示し、図4のトリガ電圧が0 Vの時、図3のトリガONの特性を示す。図4のトリガ電圧が+5 Vの時図3のトリガONの特性を示し、図4のトリガ電圧が0 Vの時図3のトリガOFFの特性を示す様にするためには、トリガ入力の前に反転回路を接続すればよい。

【0040】

この条件を満足させれば、従来のP INダイオードのバイアス極性と一致するので従来の周波数変換器と互換性が生まれ、他の周辺回路を変更することなく、本発明の周波数変換器を採用することが出来るという利点も生まれる。

【0041】

図4に示したスイッチ回路20は、本発明の周波数変換器に使用する回路の一実施例であり、他の回路構成であっても本発明の条件は満足する。

【0042】

なお、これまで図4に示したスイッチ回路20のトリガ電圧をON-OFFすることで、スイッチ回路20がゲイン制御電圧を瞬時に切り替える例を挙げてきたが、同トリガ電圧を徐々に可変することで、スイッチ回路20がゲイン制御電圧を連続的に切り替える場合には、図3のトリガONとトリガOFFの間の連続した特性も得られる。

【0043】

図5は、本発明の周波数変換器に-10 dBm一定のR F入力電力を入力し、図4の回路のトリガ電圧を0 Vから5 Vまで連続的に変化させた（スイッチ回路20がゲイン制御電圧を連続的に切り替える）時のゲインの実測値である。

【0044】

本バイアス制御回路は、トリガ入力の前に反転回路を接続した時の特性例である。

【0045】

トリガ電圧が0 Vの時のゲインは-21 dB、トリガ電圧が5 Vの時のゲインは+6 dBであり、ダイナミックレンジは、27 dBである。

【0046】

従来のP INスイッチのダイナミックレンジ15 dBに対して格段広い特性が得られる。

【図面の簡単な説明】

【0047】

【図1】本発明に係るマイクロ波周波数変換器の一実施形態の回路構成を示すブロック回路図である。

【図2】本発明に係るマイクロ波周波数変換器のタイミングチャートである。

【図3】本発明のマイクロ波周波数変換器について、トリガ電圧をON-OFFした時のR F入力電力に対するI F出力電力の実測結果である。

【図4】本発明のマイクロ波周波数変換器に使用するスイッチ回路20の一実施例である。

【図5】本発明に係るマイクロ波周波数変換器のトリガ電圧に対するゲインの実測値である。

【図6】従来のパルスレーダの構成を示すブロック回路図である。

【図7】従来のマイクロ波周波数変換器の回路構成を示すブロック回路図である。

【図8】(A)従来のR F増幅器有り、(B)従来のR F増幅器無しのマイクロ波周波数変換器の入出力特性を示すグラフである。

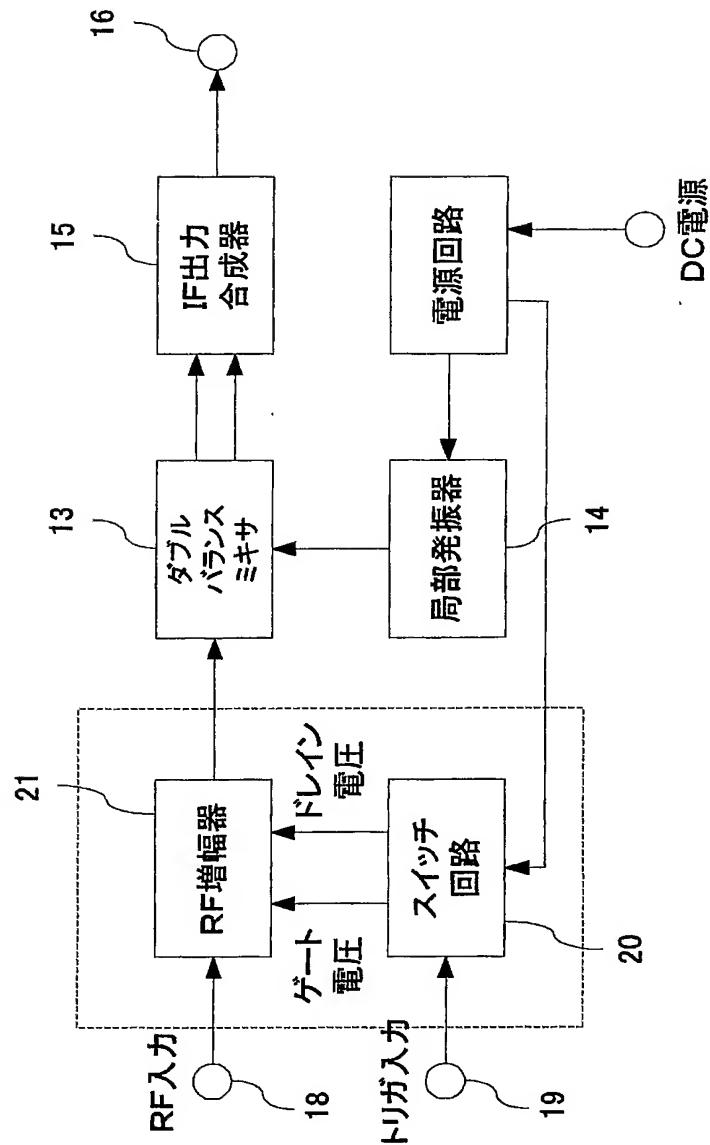
【図9】従来のマイクロ波周波数変換器の構成を示すブロック回路図である。

【符号の説明】

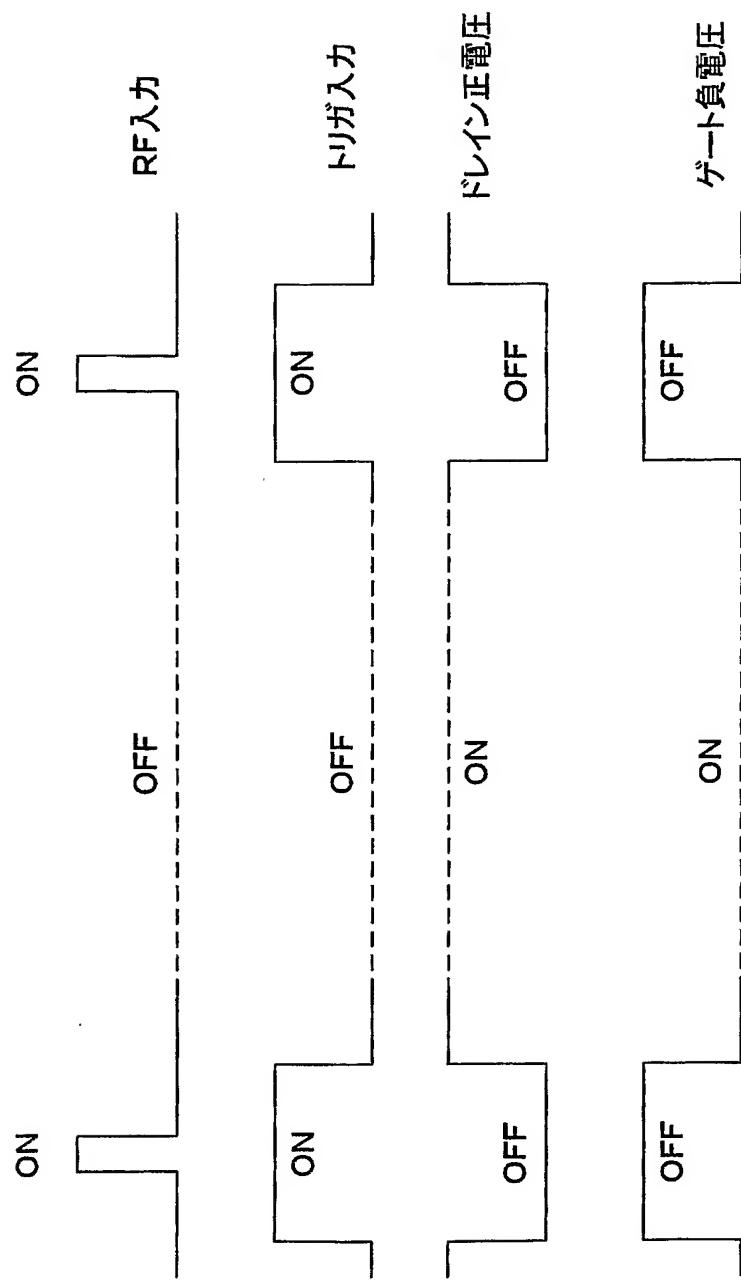
【0048】

- 1 - マグネットロン
- 2 - サーキュレータ
- 3 - アンテナ
- 4 - リミッタ
- 5 - 周波数変換器
- 6 - 局部発振器
- 7 - I F 増幅器
- 8 - 信号処理回路
- 9 - レーダ表示装置 (PPI)
- 10 - リミッタ
- 11 - リミッタの入力端子
- 12 - R F 増幅器
- 13 - ダブルバランスミキサ
- 14 - 局部発振器
- 15 - I F 出力合成器
- 16 - I F 出力端子
- 17 - PINスイッチ
- 18 - R F 入力
- 19 - トリガ入力
- 20 - スイッチ回路
- 21 - R F 増幅器
- 25 - FET
- 26 - オペアンプ
- R1、R2、R3、R4 - 抵抗

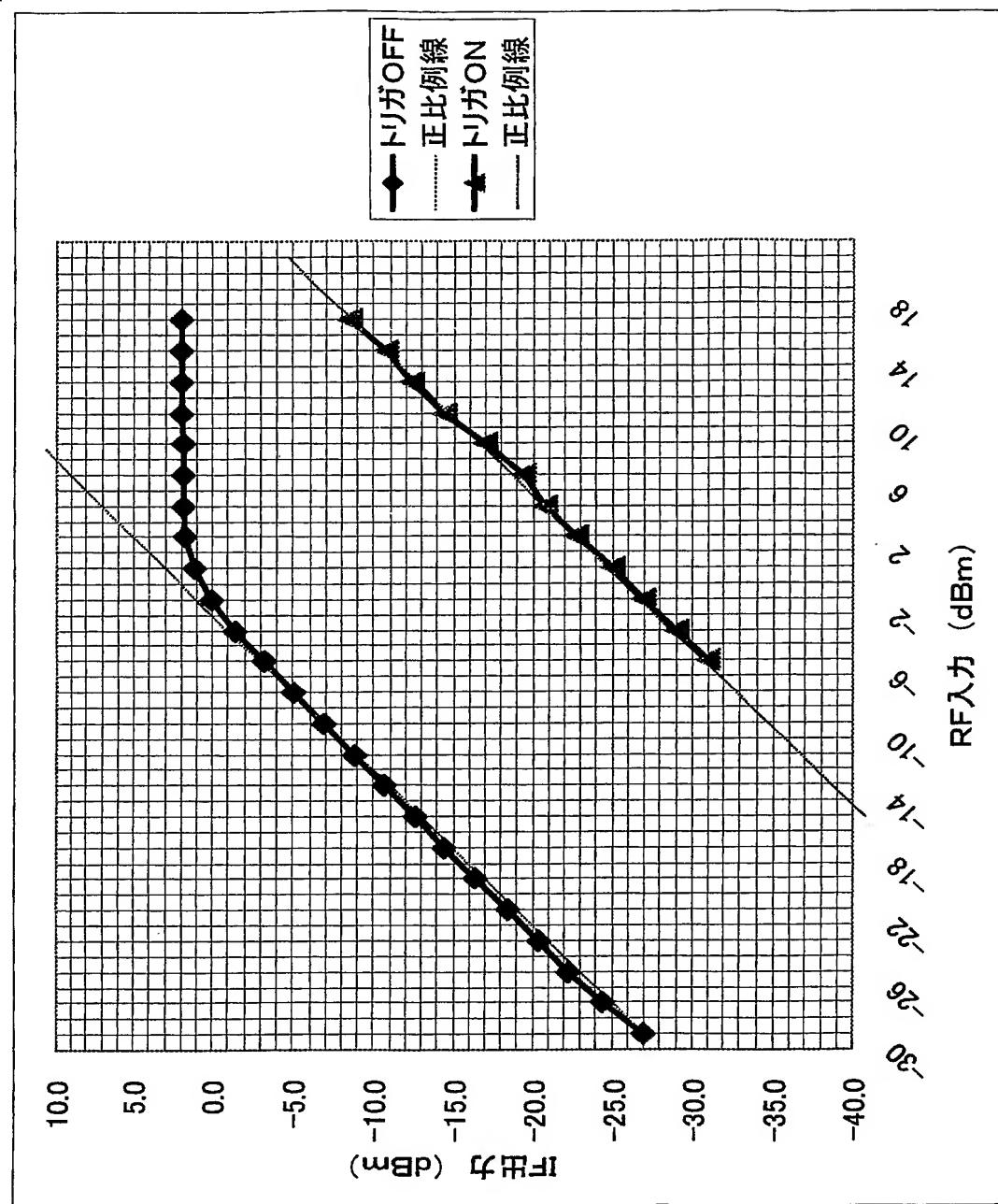
【書類名】図面
【図 1】



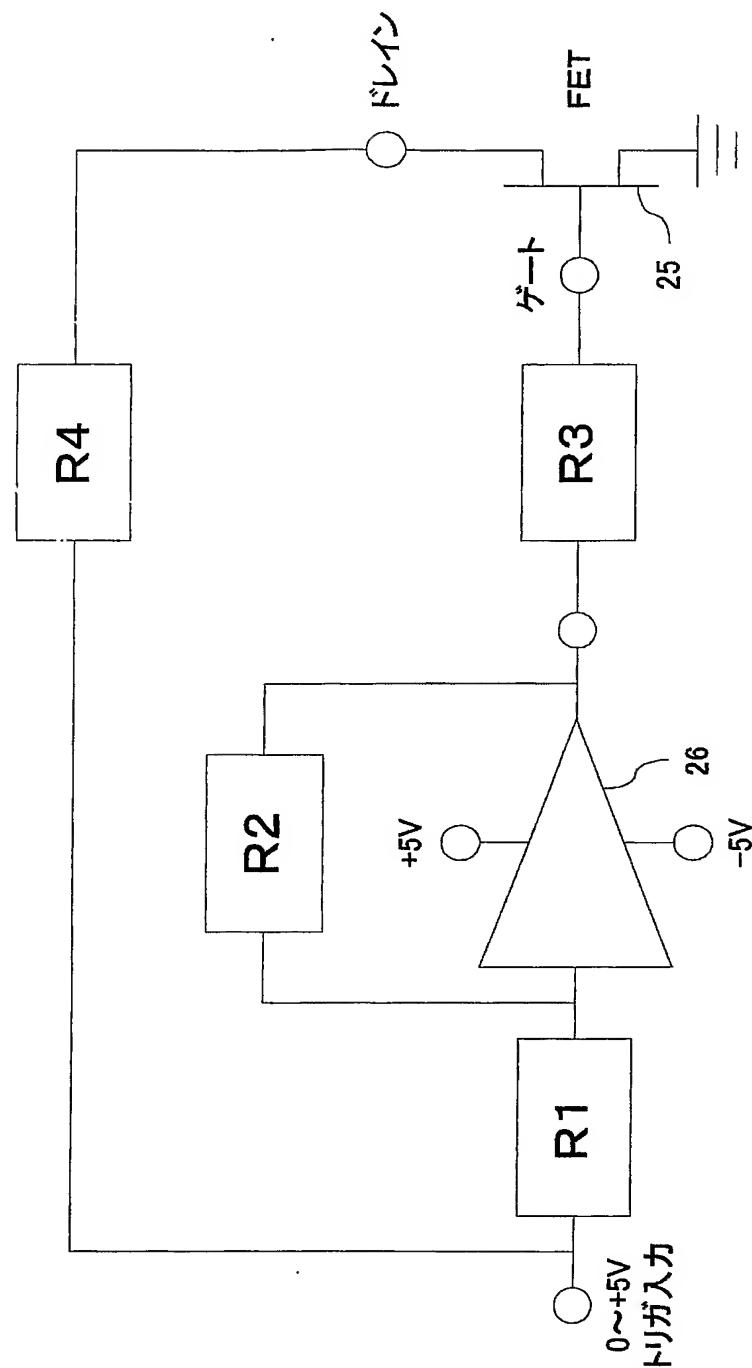
【図2】



【図3】



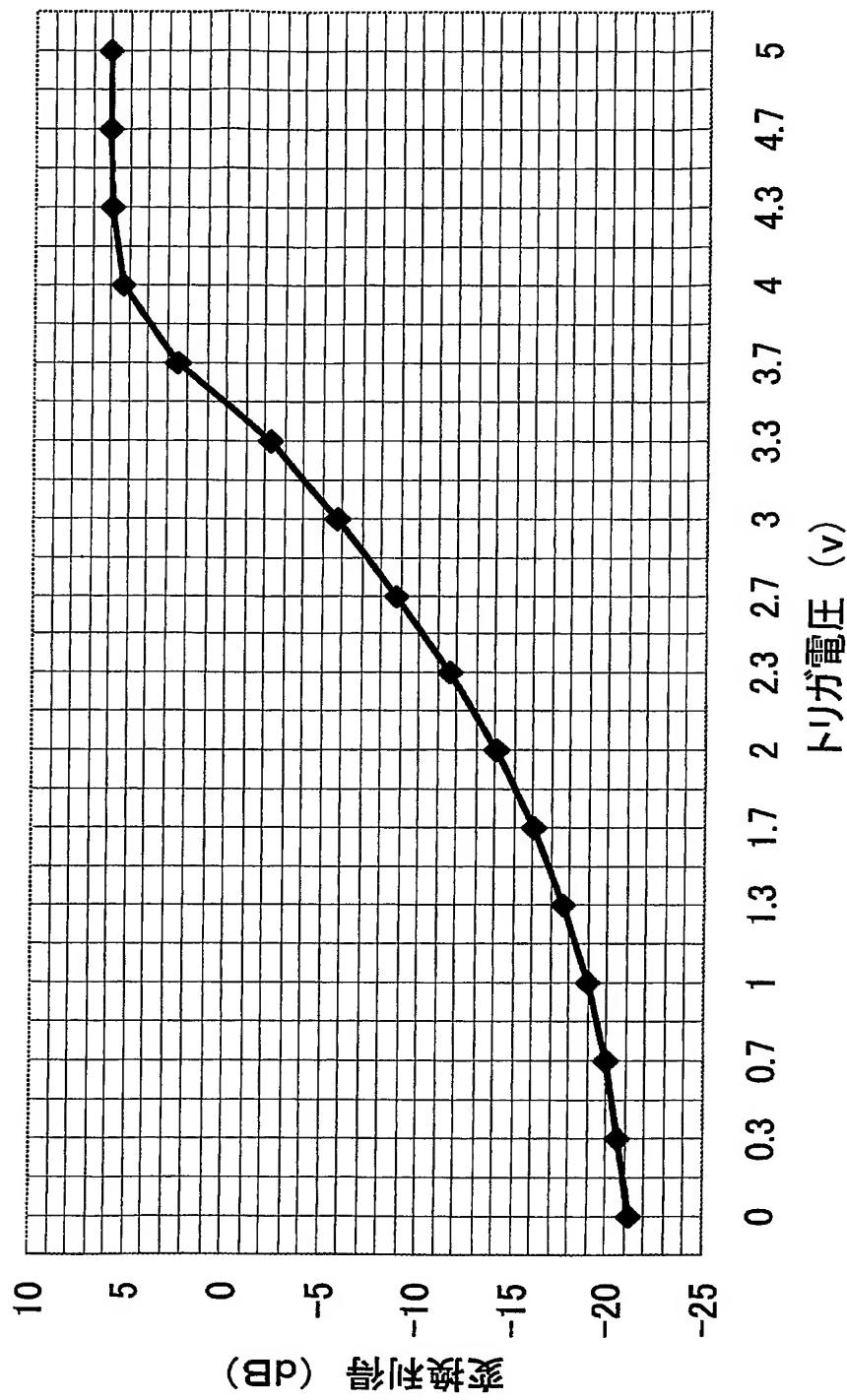
【図4】



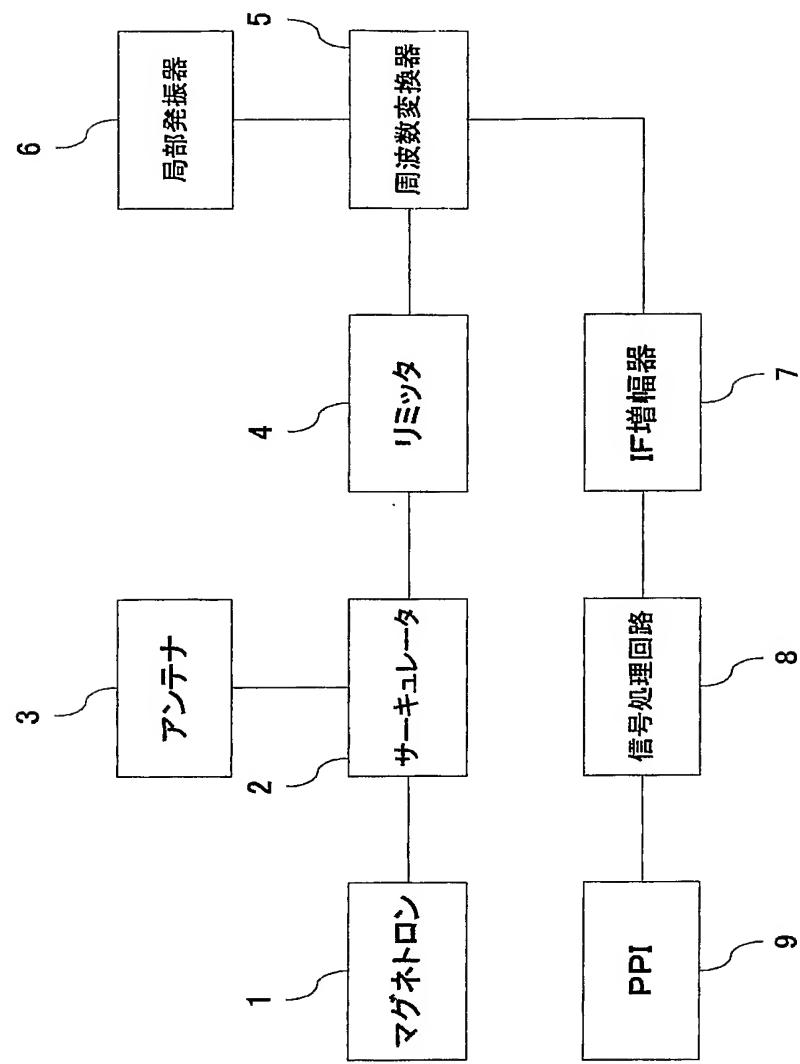
【図5】

トリガ電圧値に対する変換利得

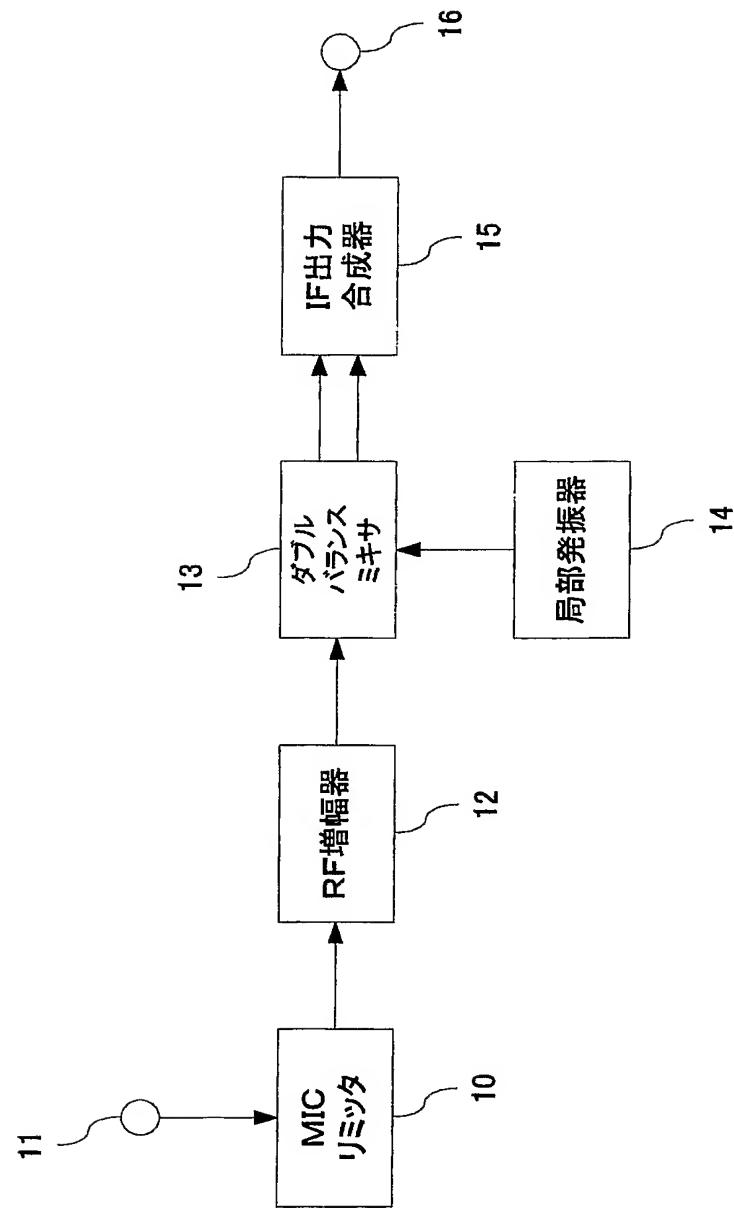
◆ — 10dBm入力



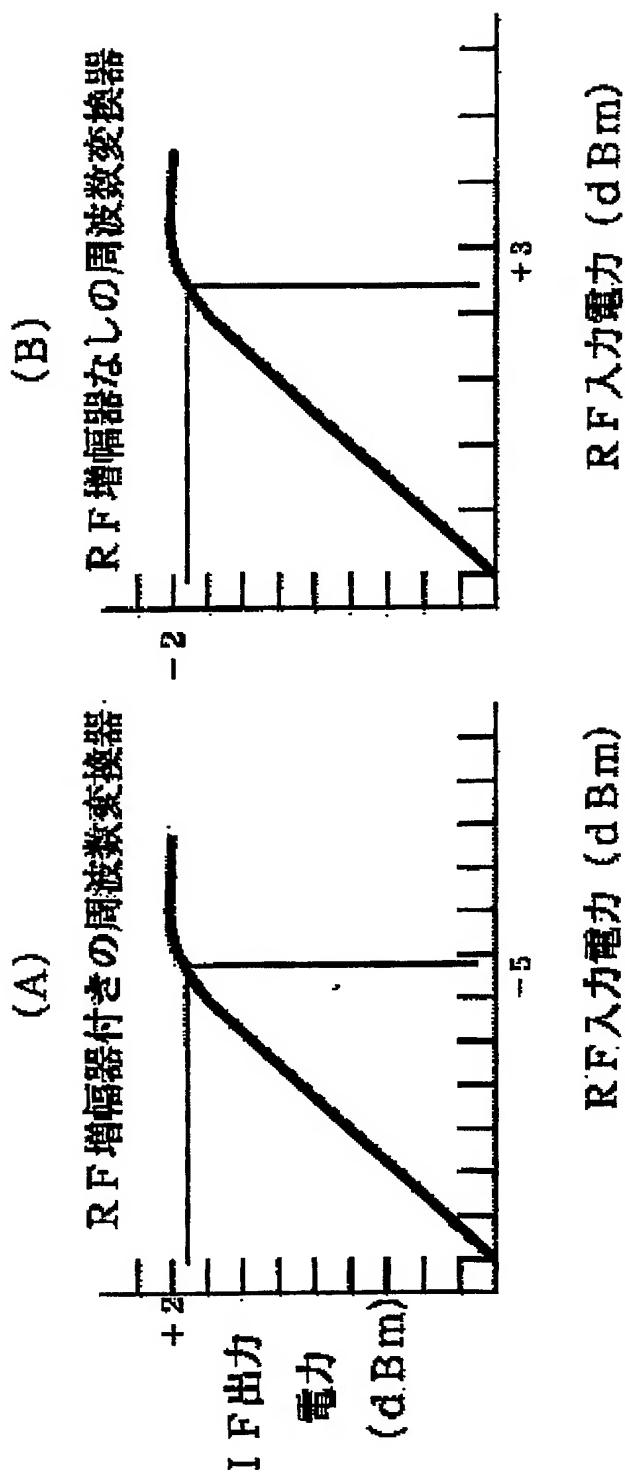
【図6】



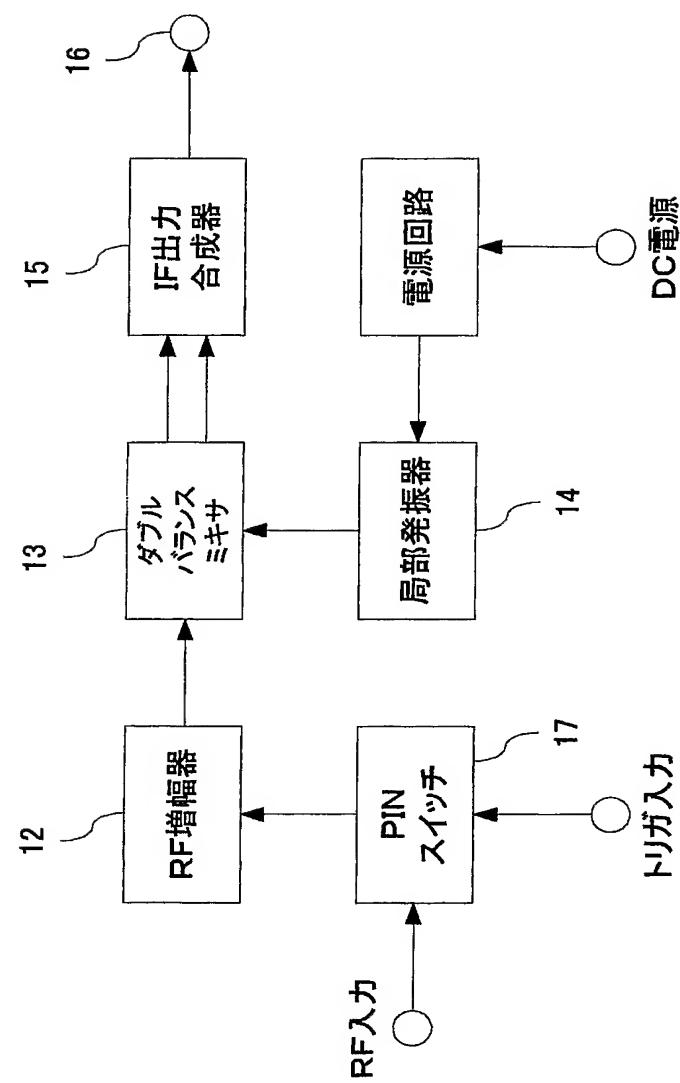
【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 マイクロ波周波数変換器の局部発信器周波数が自機マグネットロンの発振周波数に干渉するのを防ぐと共に、ごく近距離まで受信を可能にしたレーダ受信機用マイクロ波周波数変換器を提供する。

【解決手段】 マイクロ波周波数変換器に接続されたR F增幅器の電圧を自機マグネットロンの発振出力と同期させて、マグネットロンが発振している前後の時間だけ、R F增幅器に使用しているF E Tのゲートとドレインの各々の電圧を同時にO F Fすることにより、F E Tの増幅機能を減衰機能に変換し、マイクロ波周波数変換器の変換損失を増加させることによって、マグネットロンから直接入力する過大な電力のR F信号と近距離にて反射してきた過大な電力のR F信号を減衰させて、マイクロ波周波数変換器が飽和するのを防ぐと共に、局部発信器の周波数が自機マグネットロンの発振周波数に干渉するのを防止する。

【選択図】 図1

特願 2003-434888

出願人履歴情報

識別番号

[000166247]

1. 変更年月日

[変更理由]

住 所

氏 名

1990年 8月 7日

新規登録

兵庫県西宮市芦原町9番52号

古野電気株式会社

特願 2003-434888

出願人履歴情報

識別番号

[504004979]

1. 変更年月日

[変更理由]

住 所

氏 名

2003年12月26日

新規登録

神奈川県川崎市宮前区宮前平1-7-5 プラムフィールド4

F

株式会社エクサ・テクノロジー